APPLIKATION INFORMATION

aus JENA

JENOPTIK JENA GmbH Carl-Zeiss-Straße 1 Jena DDR-6900

MIKROSKOPIE

3/87

Hinweise zum Einsatz von Interferenzmikroskopen zur Schichtdickenmessung in der Halbleitertechnik

Seit mehr als 15 Jahren bewähren sich Jenaer Interferenzmikroskope vom Typ INTERPHAKO zur Lösung unterschiedlichster Aufgaben. Als eine der Hauptanwendungen hat sich
die Bestimmung von Schichtdicken in der Halbleiterforschuhg und -industrie herauskristallisiert.

Das bisher für dieses Meßproblem angebotene Auflicht-

Das bisher für dieses Meßproblem angebotene AuflichtInterferenzmikroskop EPIVAL interphako wurde im Rahmen
der Einführung der neuen Reihe der JENA-MIKROSKOPE 250-CF
durch das JENAVERT interphako ersetzt. Unter Beibehaltung
des bewährten Meßprinzips konntendie Justierung und die
Messung mit dem Gerät wesentlich vereinfacht und die
Abbildungsqualität erhöht werden.

Die folgenden Ausführungen sollen dem Anwender die Spezifik der Interferenzmikroskopie gegenüber anderen gebräuchlichen Schichtdickenmeßverfahren erläutern, einen Überblick zu den am JENAVERT interphako möglichen Meßmethoden geben und Hinweise zur Auswahl einer optimalen Gerätekonfiguration liefern.

1. Verfahren der Schichtdickenmessung im Nanometerbereich

In der Halbleitertechnik existiert ein breites Spektrum von elektrischen, optischen und mechanischen Meßverfahren zur Bestimmung der Dicke von Leiterzügen und ähnlichen durch Aufdampfen oder Aufsputtern bzw. durch Herausätzen entstandenen Strukturen.

Mit der Messung des Widerstandes bzw. der Kapazität bei leitenden bzw. nichtleitenden Schichten sind Dicken bis 1 nm prinzipiell meßbar. Bei komplexen Strukturen sind der Methode jedoch Grenzen gesetzt.

Eine weit verbreitete Meßtechnik beruht auf dem Schwingquarzverfahren, bei dem über die Verstimmung eines Oszillators die Schichtdicke bestimmbar ist. Sie eignet sich für die Messung währendder Schichtherstellung im Vakuum. Die minimale Dicke liegt bei 0,5nm, eine zusätzliche Kalibrierung ist unvermeidbar.

Unter den optischen Methoden besitzt die Fotometrie eine besondere Bedeutung. Im Gegensatz zu der schnellen und einfachen Meßwertgewinnung, ist die Auswertung nur unter Einsatz von Rechentechnik und unter Einbeziehung von entsprechenden Eichwerten möglich, da die Reflexions- und Transmissionswerte stark material- und wellenlängenabhängig sind. Der Meßbereich liegt zwischen 5nm und 2 µm.

Höchste Genauigkeit und den Vorteil der Absolutmessung bietet die Ellipsometrie. Sie ist vorwiegend für nicht absorbierende Materialien geeignet. Der Durchmesser des Lichstrahls liegt bei etwa 1mm und kann durch Zusatz-optik auf 25 µm eingeengt werden. Kleinere Details sind nicht erfaßbar. Der Meßbereich liegt zwischen 1nm und 2 µm. Die Berechnung von Dicke und Brechungsindex erfolgt mit Hilfe von Rechnerprogrammen. Für größere Probenmengen sind entsprechende automatisierte Geräte im Einsatz. Eine direkte Messung von Schichtdicken ist auch durch mechanisches Antasten möglich. Hochwertige Geräte erlauben Messungen bis unter 100 nm. Die Hændhabung ist relativ kompliziert. Die Beschädigung der Oberfläche ist bei leistungsfähigen Geräten gering, kann aber nicht völlig ausgeschlossen werden.

In der Paxis wich norde inaton verschiedenen Meßverfahren in Aufwand und Meßgenauigkeit erzielt. Die Interferenzmikroskope vom Typ INTERPHAKO zeichnen sich innerhalb dieser Gerätegruppe durch folgende Vorteile aus:

- Absolutmessung durch Vergleich der Schichtdicke mit der Wellenlänge des eingesetzten Lichtes
- Anwendbarkeit verschiedener Verfahren, die sowohl die schnelle Orientierungsmessung (Streifenmethode), als auch die Arbeit in der Größenordnung der Anzeigeeinheit (0,5 nm) bezüglich Fehler und Absolutwert ermöglichen
- Meßbarkeit kleinster Strukturdetails (10 µm typisch, bis unter 1 µm möglich)
- Kombination mit üblichen lichtmikroskopischen Techniken (Kontrastierung, Breitenmessung, Fotometrie, Mikrofotografie)
- einfache Handhabung, Meßwertgewinnung und Schichtdick en berechnung
- Untersuchungen an reflektierenden und auch lichtdurchlässigen Schichten möglich

Optimale Meßergebnisse erreicht man mit INTERPHAKO-Mikroskopen nur unter bestimmten Voraussetzungen:

- Bei dem in der Mehrzahl der Fälle eingesetzten Shearing-Verfahren wird ein Doppelbild der Struktur zur Messung benutzt. Gemessen wird an Kanten, wobei vereinzelte Strukturelemente oder Randkanten ausgewählt werden sollten.
- Unterschiedliche Materialien prägen dem Licht bei Reflexion unterschiedliche Phasensprünge auf, sodaß der gemessene Gangunterschied bis maximal 30 nm abweichen kann. Für exakte Messungen wird der entsprechende Probenbereich beim Arbeiten im Auflicht mit einer Metallschicht überzogen.
- Bei Objektiven hoher Apertur weicht der Gangunterschied zwischen senkrechten und Randstrahlen voneinander ab, sodaß eine zu geringe Schichtdicke gemessen wird.

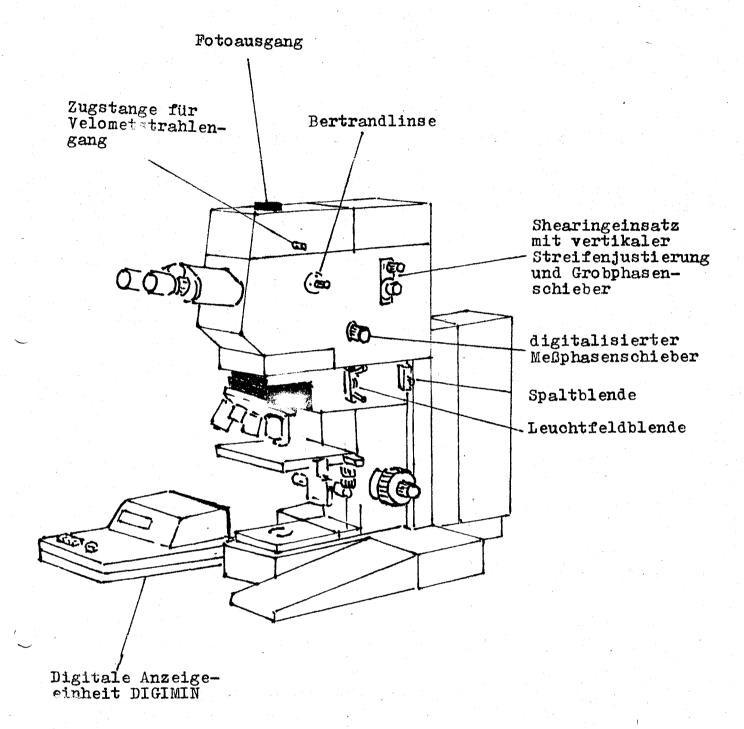
 Bevorzugt wird deshalb ein Objektiv 12,5x oder 10x eingesetzt (Fehler < 1%) oder die Aperturblende eingeengt.

Di Überlagerung von Lichtwellen in einem bestimmten Raumpunkt kann je nach Phasenlage zu Verstärkungs oder Auslöschungseffekten führen.

Voraussetzung ist die Kohärenz der Lichtanteile: gleiche Wellenlänge, gleiche Schwingungsebene, genügend lange gleichzeitige Einwirkungsdauer und nichtzu große Divergenzwinkel. In der Mikroskopie werden diese Bedingungen von Lichtstrahlen, die vom gleichen Punkt der Lichtquelle ausgehen und keinen zu großen Gangunterschied besitzen, erfüllt. Die gesamte Bildentstehung im Mikroskop basiert auf Interferenzeffekten. Bei Aufspaltung des Lichtes in mindestens zwei Anteile, die unterschiedlich beeinflußt werden (Änderung des Gangunterschiedes) können mit Hilfe von Interferenzmikroskopen Gangunterschiede, Dick en und Brechzahlen von Objekten bestimmt werden. Derartige Einrichtungen existieren für Auflicht—(Mirau, Linnik bzw. Michelson) und für Durchlichtmikroskope (Jamin-Lebedeff) bzw. für beide Verfahren (INTERPHAKO) (siehe Literatur /3/,/5/).

Es soll hiernur auf die INTERPHAKO-Geräte aus der Serie der JENA-Mikrokope eingegangen werden. Sie zeichnen sich durch durch die folgenden Vorteile gegenüber den anderen Typen aus:

- Nutzung verschiedener Interferenzverfahren (Shearing, Interphako, homogenes Feld, Interferenzstreifen)
- Digitalisierung des Meßwertes und Möglichkeit der objektiven Messung
- Einsetzbarkeit von Standardobjektiven (6,3x 100x) und LD-Objektiven (8x, 16x, 25x)
- Variation der Aufspaltung beim Shearingverfahren zwischen Auflösungsgrenze des Mikroskops und ca. 500µm.



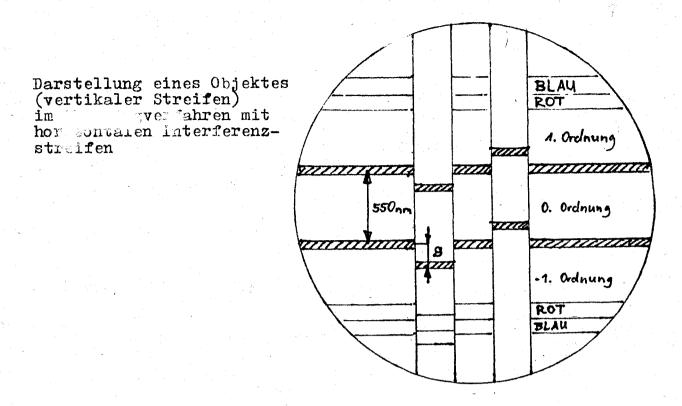
Auflichtinterferenzmikroskop JENAVERT interphako Die Interferenzmikroskope JENAVERT, JENAVAL und JENAPOL
INTERPHANO beden auf den Grundstativen der Auflicht-,
- und Polarisationsforschungsmikroskope aus der
Serie der JE roskope 250-CF auf, sodaß eine Nutzung
des entsprechenden Zubehörsortiments möglich ist.
Als Lichtquelle dient eine 12V/100W-Halogenleuchte. In einen
Filterrevolver können Interferenzfilter zur Erzeugung von
monochromatischem Licht eingesetzt werden.

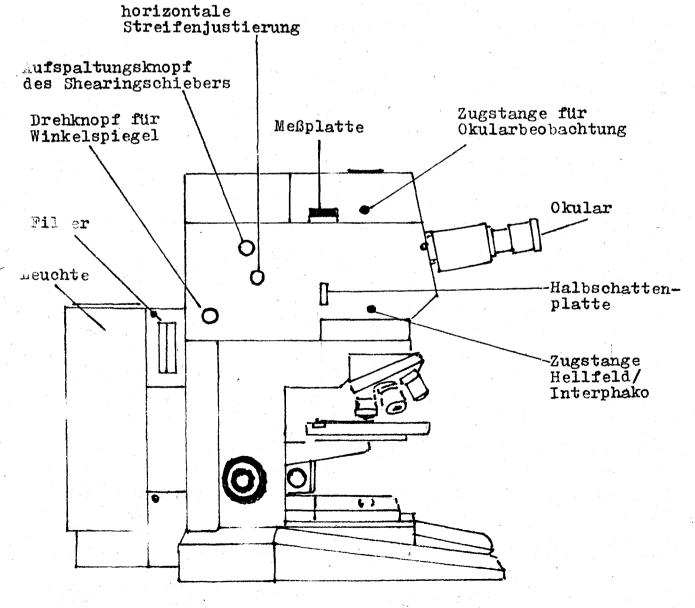
an accieller Interferenztubus mit einem modifizierten —Z ander-Interferometer wird auf das Grundstativ aufge at. Eine erste Zwischenabbildung des Objektes liegt in diesem Tubus noch vor dem Interferometer und gestattet es eine Halbschattenplatte mit der Objektstruktur zu überlagern. Ein optisches System bildet die Austrittspupille der Objektive bzw. die Aperturblendenebene in das Interferometer ab. Die optimale Abbildung in das Interferometer und damit die ahtbarkeit der Spaltblenden bei der Justierung wird durch erschieben eines Winkelspiegels mittels Drehknopf gewährleistet.

Im Interferometer wird das Licht in zwei Strahlengänge aufspaltet, die getrennt beeinflußbar sind (Änderung des Gangunterschiedes, Richtungsjustierung, seitliche Verschiebung u.a.)
Das Verständnis der richtigen Manipulation dieser Teilstrahlengänge im Zusammenspiel mit den aperturbegrenzenden Einheiten ist
e Voraussetzung für die Bedienung dieser Geräte.

d optischen Gangunterschiedes zwischen beiden Teilern, sodaß durch Einstellen bestimmter Farben bzw. Helligen an den Referenzpunkten eine Messung erfolgen kann.
Bereich beträgt etwa 5000nm, die Anzeige befindet sich
en elektronischen Bedienpult DIGIMIN. Als kleinste angeEt sind 0,5nm ablesbar.

n die Strahlengänge seitlich zueinander justiert.
der rechten Geräteseite können Verfahrensschieber für





die Interferenzstreisen und einen Drehknops für gunterschiedsänderungen bis zu 40 Wellenlängen.
Bildausspaltung dient am Shearingschieber ein dritter aknops der auf der linken Geräteseite liegt.

Abstand der Interferenzstreifen sind variierbar.

d vertikale Streifen mit geringem Abstand oder

mogenes Feld (Streifenabstand größer als das Okularsehfeld).

Vor dem Okular existiert noch ein zweites reelles Zwischen
d, weß atten oder ein Fadenkreuz dem mikroskopischen

t len können. Zum Okular gelangt der Strahlen
n sschaltbares Prisma. Wird dieses Prisma mit

entsprechenden Zugstange (linke Geräteseite) ausgeschaltet,

das Licht direkt zum Fotoausgang oder wird durch Ein
eh eines zweiten Prismas (Zugstange auf der rechten

Geräteseite) über die Velomet-Meßblenden zum Okular geleitet.

Um Hellfeldbeobachtungen höchster Qualität durchzufuhren

n der Stahlengang auch unter Umgehung des Interferenztubus

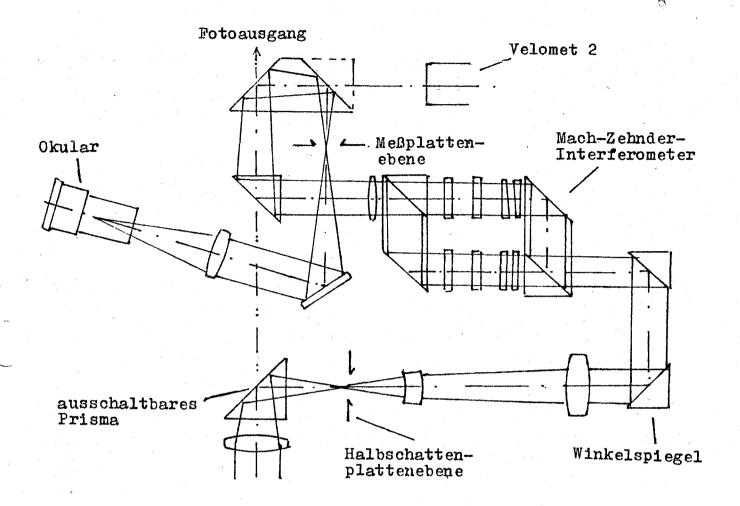
irekt zum Okular oder zum Fotoausgang geleitet werden.

Shearing-Verfahren

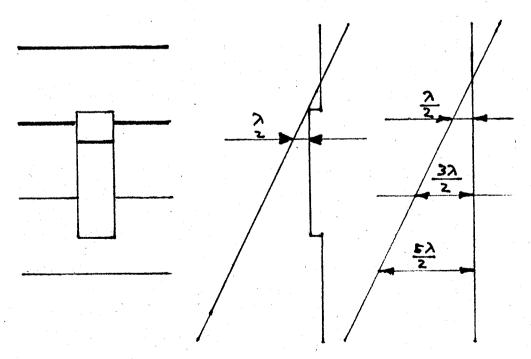
Durch seitliches Verschieben der beiden Teilstrahlengänge zueinander entsteht ein Doppelbild. Voraussetzung für die Messung ist eine Überlagerung der Objektstruktur oder -kante der Umgebung bzw. dem Untergrund.

ferenzeffekte (Auslenkung der Interferenzstreifen, mzfarbe oder Helligkeit) im Bereich der Überlagerung und Untergrund zu den Gebieten der Überlagerung und mit Untergrund.

- taufspaltung kann bis 3 mm im Zwischenbild oder je
 endetem Objektiv bis 0,5 mm in der Objektebene
 Sie wird so gewählt, daß die Interferenzeffekte im
 spaltenen Bereich noch gut erkennbar sind.
- e Gitterkonstante eingestellt.
- Je och Justierung der beiden Strahlengange zueinander können erferenzstreifen oder homogenes Feld erzeugt werden.



Interferenztubus der INTERPHAKO-Mikroskope



Streifenversetzung im Objekt

Gangunterschied im Objekt und in der Umgebung

hichtdicke bei Auflichtmessungen ergibt sich als:

d = g/2 d: Schichtdicke g: Gangunterschied Bei höchster Genauigkeit der Messungen ist noch der wellenlängenabhängige Gerätefaktor (Änderung ca. 1% auf 100nm)

- be mit weißem Licht/Interferenzstreifen: Mit der Bebachtung der Verschiebung der dunklen Auslöschungsstreifen er O.Interferenzordnung beginnt jede Messung. Der Gangunterschied wird durch visuelle Abschätzung der Streifenversetzung oder durch Verschieben der Streifen mit dem Meßphaschieber gegenüber einem Strichkreuz bestimmt.
 Bei Gangunterschieden größer als die Lichtwellenlänge kann der Anteil an Vielfachen von λ nur mit diesem Verfahren mittelt werden.
- weißes Licht/homogenes Feld: Nutzung des Purpur der ersten Interferenzordnung als Referenzfarbe (höchste Empfindlichbeit des Auges für Farbänderungen), Kompensation mit dem
 Bphasenschieber
 - mo romatisches Licht/Interferenzstreifen: Ihre Sichtbarkeit im ganzen Bereich des Grobphasenschiebers ermöglicht
 essung größerer Gangunterschiede. Um die ordnungsmäßige
 Orientierung zu ermöglichen, wird abwechselndmit weißem
 und monochromatischem Licht gearbeitet. Ein einfacher
 Wechsel ist bei Beleuchtung mit Spalt und monochromatischem
 icht der Wellenlänge 589nm (orange) möglich.
- monochromatisches Licht/homogenes Feld: Als Referenzstelle ird game Dunkelheit der Objektstelle genutzt, vorteil-haft ist die Verwendbarkeit des wellenlängenabhängigen erätefaktors.

onochromatisches Licht/homogenes Feld/Halbschattenplatte:
em Objekt wird eine zusätzliche Phasenstruktur überlagert,
de urch kann als Meßpunkt gleiche Helligkeit in nebeneinanden Bildbereichen verwendet werden.

Zusatzeinrichtung: Die Helligkeitsdifferenz der hattenplattenmethode wird in ein elektrisches Signal gewandelt, daß einen wesentlich schnelleren und genaueren leich ermöglicht. Im Bereich bis 40nm ist ein direkte gunterschiedsanzeige realisierbar.

einem der beiden Teilstrekt minge wird mit Hilfe von zichen INTERPHAKO-Ringbladen Strukturinformation des Geschaftekt, soda Helligkeitsinformation (ungebeugtes Licht) dem zweiten Teilbild überlagert wird. Grundlage dieses Verfahrens ist der auch beim Phasenkonte und beim zentralen Dunkelfeld genutzte Effekt, daß in er hinteren Brennebene des Mikroskops Helligkeitsund Strukturinf mation (vom Objekt unbeeinflußtes und am Objekt gesugtes beht) räumlich getrennt vorliegen und einzeln manisuliert werden können. Die Methode eignet sich nur für kleise Objekte, da sonst Randaufhellungen die Meßergebnisse verfälschen können. Die Maximalgröße liegt zwischen 25µm (Objektiv 6,3x) und 1,6µm (Objektiv 100x). Gangunterschiedsmessungen werden wie beim Shearingver- fahren durchgeführt.

<u>Digitalisierung, Meßreihenstatistik und Gangunterschieds-</u> berechnung

Der entscheidende Vorzug der neuen INTERPHAKO-Mikroskope ist die digitale Anzeige der Meßphasenschiderstellung auf dem zur Grundausrüstung gehörenden Bedienpult DIGIMIN.

Durch Tastendruck kann einer der beiden Referenzpunkte als Nullpunkt definiert werden. Bei Übersichtsmessungen ist der Gangunterschied sofort ablesbar. Für exakte Meßergebnisse muß der angezeigte Wert noch mit dem um 1 bis 2% abweichenn willenlingenabhängigen Faktor multipliziert werden.

I formationen über die Reproduzierbarkeit interferenzmikroopischer Messungen lassen sich nur durch statistische
__yse der Meßdaten ermitteln. Hierfür kann das DIGIMIN
gegen eine Auswerteeinheit RETARMET 2 ausgetauscht werden.

Das RETARMET 2 berechnet außer dem Mittelwert x die Standard-

ich ig s und den Vertrauens ereich
$$d$$
.
$$\sqrt{\frac{\sum_{i}(x-x_{n})^{2}}{n-1}}$$

$$d = t_{n} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

e et einer vorgegebenen Sicherheit von 95%). Dabei geht neben der Anzahl der Messungen ein Faktor tn ein, der die Abweichung

Normal rteilung entspree der Student-oder rteilung berücksichtigt.

Messungen: $t_n = 12,7$ 5 Messungen: $t_n = 2,78$ 10 Messungen: $t_n = 2,23$ 100 Messungen $t_n = 2,0$)

ein am RETARMET 2 ein digitaler Meßtubus oder ein aurmeßfühler angeschlossen werden.

Die Bdaten werden automatisch mit den verfahrensbedingten chfaktoren multipliziert und angezeigt bzw. über einen er angegeben werden (V24/RS232-Schnittstelle).

At a fir polaristionsmikroskopische Kompensatormessungen er alt der Zapan 2 die entsprechenden Meßprogramme.

Längenmessungen

Des Ausdehnung der Strukturen in der Bildebene kann mit

- Okularmeßplatten im Meßschieber (in Grundausrüstung)

monokularem Meßtubus (Meßschraubenokular)

- binokularem Meßtubus (mit RETARMET 2)digitalisierbar)

b 'mmt werden

Sehr kleine Längen lassen sich im Shearing-Verfahren durch auf um die Objektgröße und Ausmessen des Interferenzseifena standes in der hinteren Brennebene mit hoher

$$1 = \frac{K}{d} \qquad K = \frac{C}{M}$$

d: Abstand der Inter-

d der Inter- k: wellenlängen- und vergrößerungsabhängige Konstante

igungswinkelmessungen

jungswinkel von Oberflächen (Z.B. von Schrägschliffen)
h durch gleichzeitige Messung von Aufspaltung und
d im Shearingverfahren ermitteln.

Meigenewinkel der Oberfläche in Aufspaltungsrichtung angun

Große der Afspaltung (siehe Messung kleiner Längen)

1. Grundgeräte

1.1. J. AV. T interphako (Laflicht)

Best.-nr.: 300437:761.20/7

1.2. JENAVAL interphako (Durchlicht)

Bestellar.: 300437:661.20/7

1.3. JEAPCO interphako (Durch licht, Auflicht)

Bestellnr.:

1.4. Durchlichteinr. für JENAVERT interphako

Arbeitsmöglichkeiten

He lifeld- und Interferenzkontrastmikroskopie (1.2. auch Phasenkontrast)

Messung von Gangunterschieden:

- Streifenversetzung visuell abschätzen (±50 nm)
- Streifenversetzung mit Meßphasenschieber bestimmen (+10...20nm)
- Messung im homogenen Feld (weißes Licht) ($\frac{1}{2}$ 2...10nm)
- Messung mit Halbschattenplatte (monochr. Licht) (± 1...5nm)

2. Objektivierte Messung

Einrichtung VELOMET 2 Bestellnr.: 300471:901.21/8

- -elektronische Kompensationsanzeige (Verkürzung der Meßzeit, geringere Belastung des Messenden)
- bis 40nm direkte Gangunterschiedsanzeige (\pm 0.5...2nm)
- Photometrie (bis minimal 0, 1% Reflexion oder Transmission)
- 3. Automatische Gangunterschiedsberechnung und Meßreihenstatistik

Einrichtung RETERMET 2 Bestellnr.: 300471:500.21/0

- automatische Multiplikation der der Meßergebnisse mit einem eingegebenen Faktor
- Berechnung von Standardabweichung $s = \sqrt{\hat{L}(x - x_1)/(n-1)}$ und Vertrauensbereich t • s / \(n \)
- Kopplung mit Drucker (V24-Schnittstelle)möglich

angenmessungen in der Objektebene

binokulare Meßeinrichtung Bestellnr.: 300463:301.21/2

5. Mikrofotografie

Einrichtung mf-AKS 24x36 automatic 2 pol-mot Bestellnr.: 390460:645.21/2

6. Objektverschiebung, motorisch

Einrichtung für statistische Verfahren und Koordinatenfindung Bestellnr.: 300463:802.21/5

smöglichkeiten

binokulare Messung mit Okularmessschraube (bzw. Meßplatten)
Digitalisierung und Meßreihenstatistik mit 3. möglich

automatische Belichtung und Filmtransport von Kleinbildfilmen mit Projektiven 3,2:1, 4:1, 5:1 und Bertrandsystem

programmierbare motorische Objektverschiebung in X-und Y-Richtung (75 mm x 25 mm, Schrittweite: 10um)

Autor: Wolfgang Degel

manera var has simenstellung

- 1. Schöppe, G. u.a.: JENAVAL interphako und JENAVERT INTERPHAKO die Interferenzmikroskope der JENA
 ROSKOPE 250-CF
 in: JENAER RUNDSCHAU 32 (1987) 1 S. 11-15
- 2. Beyer, H.: Theorie und Praxis der Interferenzmikroskopie

 Verlagsges. Geest&Portig K.G., Leipzig 1974
- 3. Beyer, H.: Interferenzmikroskopie

 Kap. 6.1.3 und 6.2.3. in Beyer, H. (Hrsg.): Handbuch der Mikroskopie. VEB Verlag Technik, Berlin 1977

 (3. Auflage Hrsg.: Riesenberg in Vorbereitung)
- 4. Gebrauchsanleitung JENAVAL interphako/JENAVERT interphako Druckschriften-Nr. 30-G0320. Kombinat VEB Carl Zeiss JENA
- 5. Beyer, H.: Zur praktischen Durchführung interferenzmikroskopischer Messungen an Oberflächen, insbesondere
 in Halbleitertechnik und Mikroelektronik
 in: JENAER RUNDSCHAU 22 (1977) 6 S.277-280
- 6. Werlich, R. u. a.: Digitalkompensator Retarmet 2 für Flarisations- und Interferenzmikroskope in: JENAER RUNDSCHAU 32 (1987) 1 S. 18-20
- Gäbel, K. u.a.: Einfluß der Beleuchtungsapertur auf interferenzmikroskopische Messungen in: JENAER RUNDSCHAU 32 (1987) 2 S. 66-68
- 8. Schäfer, W. u. Terlecki, G.: Halbleiterprüfung. Lichtd Rasterelektronemikroskopie Dr. Alfred Hüthig Verlag, Heidelberg 1986